

УДК 539.2·538.915
 © 1992

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЗОННАЯ СТРУКТУРА И ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНОАНТИМОНИДА ТУЛИЯ

*К. Р. Гегешидзе, Г. П. Нижникова, О. В. Фарберович,
 А. В. Гигинеишвили, Т. Л. Плавинский, Л. Н. Глурджидзе*

Впервые самосогласованным линейным методом присоединенных плоских волн рассчитаны энергетическая зонная структура и межзонная плотность состояний моноантимонида туния. Определенные в результате расчета спектры оптических параметров сравниваются со спектральными зависимостями, полученными на основе измерения отражения и прозрачности пленок TmSb.

Исследование неординарных физических свойств соединений редкоземельных элементов (РЗЭ) с промежуточной валентностью (ПВ) остается актуальной проблемой [1]. Существенно влияние ПВ на оптические характеристики материала [2]. Все еще недостаточно изучены пникиды РЗЭ [3], мало сведений о структуре их энергетических зон, хотя электронные свойства некоторых из этих соединений определяются во многом наличием именно ПВ РЗ иона [4, 5].

В данной работе впервые рассчитаны энергетическая зонная структура и спектральные зависимости оптических параметров моноантимонида туния (кубическая структура типа NaCl, параметр решетки объемного кристалла 6.090 Å [6], пленки — 6.07 Å [5]). Полученные данные сравниваются с результатами экспериментального исследования оптических спектров, проведенного на пленках золотистой окраски, валентность туния в которых, согласно данным абсорбционной рентгеновской L₃-спектроскопии [5], составляет 2.7 ± 0.1 .

Однофазные, поликристаллические, с частично сформированной текстурой пленки толщиной 0.1—0.5 мкм были приготовлены вакуумным термическим испарением на сапфировых и кремниевых подложках [7]. Измерения отражения и прозрачности при 300 К проводились на спектрально-вычислительных комплексах КСВУ-2 (в УФ и видимой областях спектра) и КСВИ (для ИК области на базе спектрометра ИКС-31).

Энергетическая зонная структура монокристалла моноантимонида туния (рис. 1) рассчитана самосогласованным линейным методом присоединенных плоских волн (ЛППВ) в формализме функционала электронной плотности [8]. Применение скалярно-релятивистского приближения позволило учесть скалярно-релятивистские поправки к энергетическому положению уровней [9]. Спин-орбитальное расщепление при релятивистских вычислениях энергетического спектра электронов Тш включено на последней стадии расчета, после получения самосогласованного кристаллического потенциала. В расчет были включены $4f^{13}6s^2$ (Tm) и $5s^25p^3$ (Sb) оболочки, а остальные электроны были отнесены в остаток, состояния которого пересчитывались на каждой итерации. Сведения об используемых величинах: постоянной решетки, радиусах МТ сфер (определенных по точке пересечения потенциалов атомоподобных областей на нулевой итерации), параметрах E , линеаризации метода ЛППВ (выбирались вблизи центров соот-

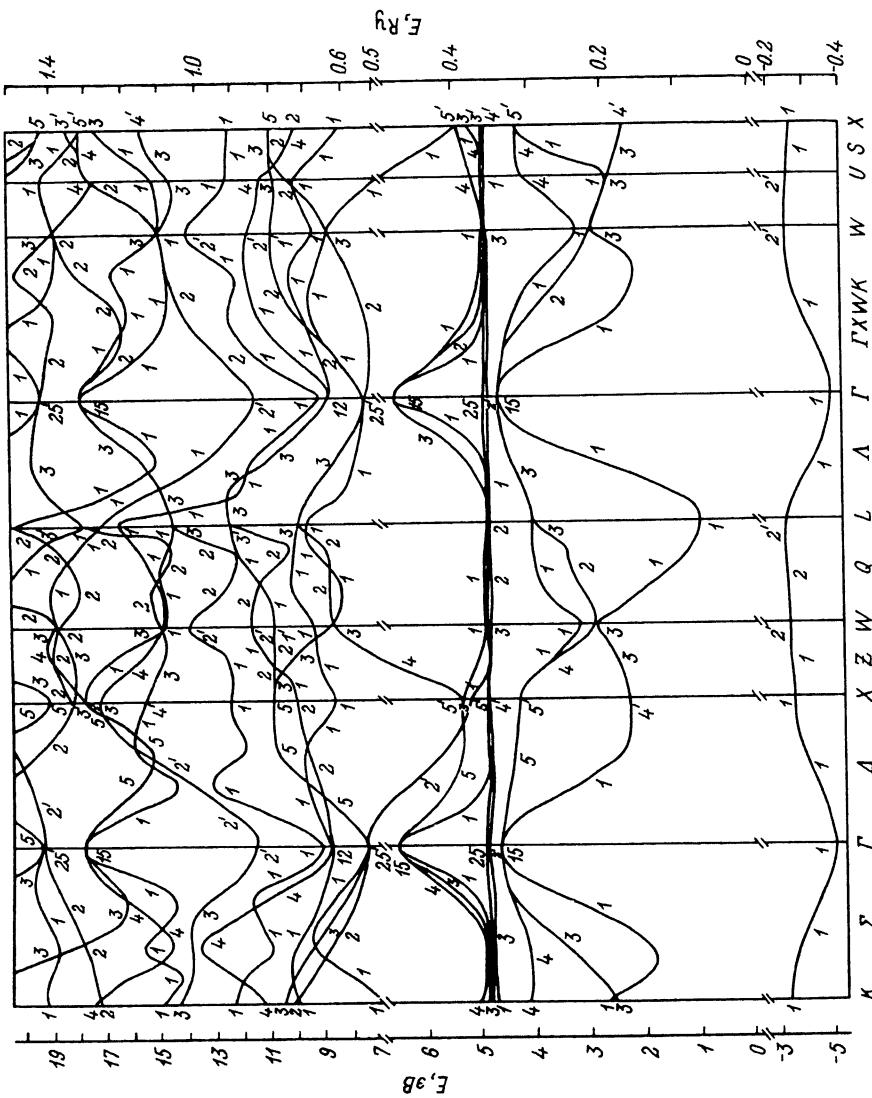


Рис. 1. Энергетическая зонная структура моноантимонида тутлия.

Таблица 1

Основные параметры расчета зонной структуры TmSb ($a = 6.07 \text{ \AA}$)

	R_{m-t} , ат. ед.	E_I , Ry				
		$I = 0$	$I = 1$	$I = 2$	$I = 3$	$I = 4$
Tm	2.852	0.61	1.3	0.54	0.35	1.4
Sb	2.883	-0.3	0.32	1.4	1.4	1.4

ветствующих зон) приведены в табл. 1. Самосогласование по электронной плотности было достигнуто после 58 итераций (параметр самосогласования $\alpha = 0.95$). Собственные значения энергии рассчитаны в сетке из 89 точек в неприводимой части зоны Бриллюэна, в интервале энергии $-0.5 \div -1.5 \text{ Ry}$ около МТ нуля и были стабилизированы с точностью $\sim 10^{-5} \text{ Ry}$. Уровень Ферми определялся через функцию плотности состояний, вычисление которой проводилось комбинированным тетраэдрическим методом с использованием квадратичной интерполяции собственных значений энергий.

Электронные плотности состояний на уровне Ферми ($E_F = 0.3629 \text{ Ry}$, проходит через f -полосу) приведены в табл. 2. Там же представлены парциальные заряды валентных электронов в МТ сferах. Из двух 6s-электронов атома Tm в МТ сфере остается лишь 0.396 электрона, которые распределены по s - и p -состояниям; 0.428 5s-электронов и 0.534 5p-электронов Sb также оказываются вне области МТ сфер. Некоторая часть этих электронов переходит в d - и f -подобные состояния (соответственно 0.052 и 0.013 электрона). Полный заряд вне МТ сфер составляет 2.498.

Таблица 2

Значения плотности состояний на уровне Ферми ($n^I(E_F)$, сост./Ry, атом) и заряды валентных электронов в $(m-t)$ -сферах туния и сурьмы (Q^I , эл. зарядов)

		s	p	d	f	Электроны			
						между-атомные	полные	остовные	валентные
n	Tm	0.352	0.374	4.276	182.764	7.233	204.176		
	Sb	0.104	8.430	0.557	0.117				
	Tm	0.203	0.193	0.565	12.431	2.498	20.0	54	13.392
	Sb	1.572	2.466	0.052	0.013			46	4.103

Валентная зона моноантимонида туния формируется в основном 5s- и 5p-состояниями сурьмы и 4f-состояниями туния. Узкая f -полоса (с расположенным в ней уровнем Ферми) разделяет довольно широкие валентные зоны (табл. 3), которые образованы гибридизированными p (Sb), f (Tm)-состояниями. Причем если в нижнюю из них приоритетный вклад дают p -электроны (около 70% p -подобных и 30% f -подобных состояний), то для верхней ситуация обратная. 4f-электроны туния и 5p-электроны сурьмы находятся в состояниях одинаковой симметрии (например Γ_{15} , X_5 -состояния вдоль направления Δ). Перекрытие волновых функций этих электронов приводит к сильному $p-f$ взаимодействию, обусловливая заметную дисперсию зон даже с основополагающим вкладом f -состояний (например, вдоль направлений Δ и Σ ; рис. 1). Гибридизирована и зона проводимости, в формировании которой наряду с d - и f -состояниями туния участвуют и p -подобные состояния сурьмы.

Наличие помимо f -полосы гибридизированных, обладающих существенной дисперсией, $p-f$ и $f-p$ валентных зон является характерной особенностью

Таблица 3
Энергетические параметры (эВ) зонной структуры TmSb

E_F	Ширина валентных зон			
	ΔE_S	ΔE_{pf}	ΔE_f	ΔE_{fp}
4.937	1.528	3.741	0.099	1.733

Таблица 3 (продолжение)

E_F	Энергетические зазоры						
	Γ_{pf-f} (15'-2')	Γ_{f-f} (2'-25)	Γ_{f-f_p} (25'-15)	X_{pf-f} (5'-4')	X_{f-f} (4'-3')	X_{f-f_dp} (3'-3)	
4.937	0.189	0.059	1.688	0.535	0.043	0.324	0.131

строения электронного спектра TmSb. Значительная дисперсия (в отличие от монохалькогенидов туния [10, 11]) зон, образованных f -состояниями, предопределяет и их существенный вклад в оптические закономерности. Значения некоторых межзонных энергетических зазоров приведены в табл. 3.

Основным параметром, связывающим зонную структуру и оптические характеристики кристалла, является мнимая часть диэлектрической проницаемости.

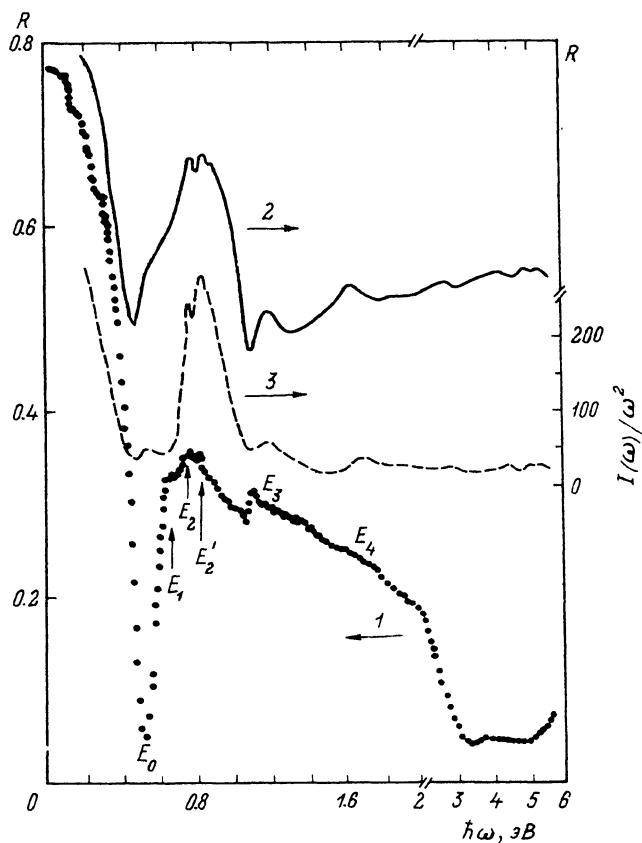


Рис. 2. Спектры отражения (I — эксперимент, 2 — теория) и рассчитанная межзональная плотность состояний (3).

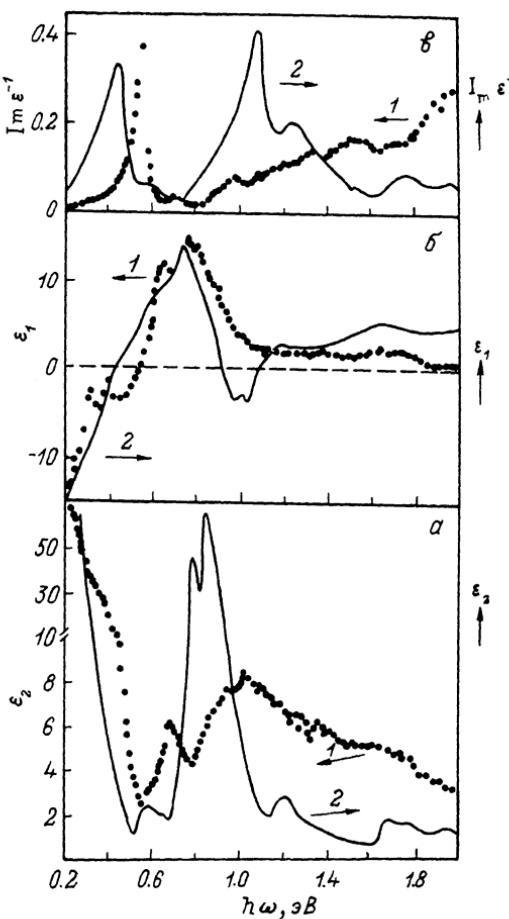


Рис. 3. Спектры мнимой (а) и действительной (б) части диэлектрической проницаемости и функции потерь (в).

1 — эксперимент, 2 — теория.

В [12] описан алгоритм для расчета (по дисперсионному соотношению Крамерса—Кронига на основе $\epsilon_2(\omega)$) частотной зависимости действительной части диэлектрической проницаемости и остальных оптических параметров. Некоторые из них представлены на рис. 2, 3 вместе с экспериментальными данными и рассчитанной межзонной плотностью состояний. Как видно из этих рисунков, структуры в оптических спектрах моноантимонида титана проявляются в основном при $\hbar\omega < 2$ эВ, причем имеет место довольно хорошее согласие теории и эксперимента.

Характерной особенностью спектра отражения является наличие глубокого минимума E_0 , за которым следует основная полоса, содержащая несколько структур E_1, E_2, E_2' . Довольно четко проявляются еще два максимума отражения E_3 и E_4 . Значения энергий этих структур указаны в табл. 4.

Особенности E_1 и E_2 играют основополагающую роль и в спектрах ϵ_2 . Очевидно также, что величина E_0 определяет минимальную энергию межзонных переходов электронов из относительно широких валентных зон в незанятые состояния выше уровня Ферми. При более низких энергиях возможны переходы лишь из узкой f -полосы, как это видно (рис. 4) по парциальным вкладам различных валентных зон в межзонную плотность состояний. Большая плотность занятых и свободных состояний (различного «генетического происхождения»)

Таблица 4

Энергетическое положение (эВ) и идентификация структур в оптических спектрах

		E_0	E_1	E_2	E'_2	E_3	E_4
R	Эксп.	0.51	0.67	0.77	0.81	1.1	1.6
	Теор.	0.48	0.58	0.80	0.86	1.2	1.66
ε_2	Эксп.		0.68	0.9	1.0	1.2	1.6
	Теор.		0.58	0.79	0.84	1.2	1.68
Идентификация		$\Delta_5 - \Delta_2$, $X_5 - X_3$	$\Sigma_4 - \Sigma_1$, $\Sigma_4 - \Sigma_3$	$\Sigma_4 - \Sigma_4$		$\Sigma_1 - \Sigma_1$, $\Delta_1 - \Delta_1$	$\Sigma_1 - \Sigma_4$
Энергия перехода		0.57, 0.58	0.79, 0.80	0.87		1.22, 1.11	1.65

вблизи уровня Ферми, видимо, и обуславливает существенный рост оптических параметров при $\hbar\omega < 0.2$ эВ. В табл. 4 приведены межзонные переходы электронов (идентификация, значения зазоров), ответственные за наблюдаемые в оптических спектрах структуры.

В длинноволновой области ε_1 имеет отрицательную величину, а пересечению нуля (с положительным наклоном) зависимость $\varepsilon_1(\omega)$ при 0.55 эВ сопутствует хорошо сформированный пик в спектре функции потерь (рис. 3), что указывает

на вклад плазмонов с этой характеристической энергией в дисперсию оптических постоянных. Естественно, что в низкочастотном диапазоне возможно и проявление структур, обусловленных фононами или примесными состояниями. Однако имеющиеся данные не позволяют пока судить о вкладе этих механизмов.

Таким образом, выявленное теоретическим и экспериментальным подходами своеобразие оптических спектров моноантимонида туния связано с энергетической близостью и гибридизацией f -, p - и d -подобных состояний в пределах валентных зон и зоны проводимости в окрестности уровня Ферми. На основе прямых межзонных $pf-f(f)p$

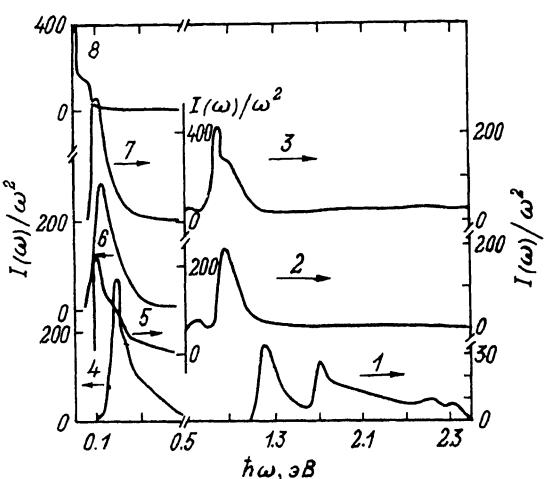


Рис. 4. Парциальные вклады валентной pf -зоны (1—3) и f -полосы (4—8) в межзонную плотность состояний.

переходов электронов удалось идентифицировать и согласовать спектральные особенности и особенности межзонной плотности состояний в диапазоне 0.5—2 эВ. В низкоэнергетической области ($\hbar\omega < 0.2$ эВ) существенны возбуждения из сильнолокализованной f -полосы. Тем не менее, исходя из строения энергетических зон, нельзя полностью исключить и возможность вклада других механизмов (например, непрямых переходов).

Авторы благодарны И. А. Смирнову за постоянный интерес к работе.

Список литературы

- [1] Steglich F. // J. Phys. Chem. Solids. 1989. V. 50. N 3. P. 225—232.
- [2] Travaglini G., Wachter P. // Phys. Rev. B. 1984. V. 29. N 2. P. 893—898.
- [3] Gasgnier M. // Phys. Stat. Sol. (a). 1989. V. 114. P. 11—71.
- [4] Suga S. // Physica Scripta. 1987. V. 17. P. 228—239.

- [5] Глурджидзе Л. Н., Дадиани Т. О., Джабуа З. У., Плавинский Т. Л., Гигинеишвили А. В., Докадзе Э. В., Санадзе В. В., Филькенштейн А. Д., Ефремова Н. И. // Материалы 4-го семинара СССР—ФРГ (Сухуми, 1987 г.). Тбилиси, 1988. С. 167—172.
- [6] Самсонов Г. В., Абдусаламова М. Н., Шокиров Х., Пряхина С. А. // Изв. АН СССР, неорганс. матер. 1974. Т. 10. № 11. С. 1951—1954.
- [7] Дадиани Т. О., Докадзе Э. В., Джабуа З. У., Лочошвили Т. С., Глурджидзе Л. Н., Санадзе В. В. // Сообщения АН ГССР. 1989. Т. 134. № 2. С. 365—367.
- [8] Блувштейн И. М., Власов С. В., Нижникова Г. П., Фарберович О. В. // Деп. в ВИНИТИ. 1988. № 2791-В88. 41 с.
- [9] Farberovich O. V., Nizhnikova G. P., Vlasov S. V., Domashevskaya E. P. // Phys. Stat. Sol. (a). 1984. V. 211. N 1. P. 241—253.
- [10] Фарберович О. В., Нижникова Г. П., Власов С. В., Домашевская Э. П. // ФТТ. 1984. Т. 26. № 2. С. 554—556.
- [11] Кикоин К. А., Нижникова Г. П., Фарберович О. В. // ФТТ. 1987. Т. 29. № 3. С. 803—812.
- [12] Власов С. В., Куркина Л. И., Нижникова Г. П., Степанова Е. В., Фарберович О. В. // Деп. в ВИНИТИ. 1988. № 4125—В88. 3 с.

Грузинский технический университет
Тбилиси

Поступило в Редакцию
29 апреля 1991 г.
В окончательной редакции
28 октября 1991 г.
